

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 1 区分
 【発行日】平成 23 年 3 月 17 日 (2011.3.17)

【公表番号】特表 2010-519705 (P2010-519705A)
 【公表日】平成 22 年 6 月 3 日 (2010.6.3)
 【年通号数】公開・登録公報 2010-022
 【出願番号】特願 2009-550960 (P2009-550960)
 【国際特許分類】

H 0 5 B 33/04 (2006.01)
 C 2 3 C 16/27 (2006.01)
 H 0 5 B 33/10 (2006.01)
 H 0 1 L 51/50 (2006.01)
 C 2 3 C 16/505 (2006.01)

【F I】

H 0 5 B 33/04
 C 2 3 C 16/27
 H 0 5 B 33/10
 H 0 5 B 33/14 A
 C 2 3 C 16/505

【手続補正書】
 【提出日】平成 23 年 1 月 25 日 (2011.1.25)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

水分又は酸素に弱い電子デバイスの保護のための非晶質ダイヤモンド状フィルム層を製作するプロセスであって：

シリコン油からプラズマを形成する工程と；

該プラズマから非晶質ダイヤモンド状フィルム層を蒸着する工程と；

該非晶質ダイヤモンド状フィルム層と水分又は酸素に弱い電子デバイスとを組み合わせ、保護された電子デバイスを形成する工程とを含む、プロセス。

【請求項 2】

有機電子デバイスと；

該有機電子デバイスに近接した非晶質ダイヤモンド状フィルム層とを含んでおり、該非晶質ダイヤモンド状フィルム層は、シロキサン部分を含み、1000 オングストロームを超える厚さを有する、物品。

【請求項 3】

電力供給される電極と対電極とを含む真空チャンバと；

該電力供給される電極とインピーダンス整合回路網を通じて電気的接続する高周波電源と；

該真空チャンバと流体連通するシリコン油源とを含む、プラズマ蒸着装置。

【請求項 4】

基板上に非晶質ダイヤモンド状フィルム層を製作するプロセスであって：

シリコン油から高周波プラズマを形成する工程と；

プラズマから基板上に非晶質ダイヤモンド状フィルム層を蒸着する工程とを含むプロセ

ス。